

[1] 設計者姓名及聯絡電話

不可將老師名字及學校名稱列出!!

學生姓名：張小明

聯絡電話：0912345678、03-5773693 # 999

[2] 專題名稱

中文專題名稱：25GHz 低功率 CMOS 差動振盪器

英文專題名稱：A 25GHz Current Reused Differential Oscillator

[3] 最近三次下線紀錄

下線梯次與晶片編號	專題名稱	量測結果
T18-97C-001	5GHz 低雜訊放大器	function work
T18-100C-034	低功率 CMOS 差動振盪器	partial work

[4] 全新設計或改版說明

說明：此項目請用以下三種分類進行選擇並做相關說明：

(1)設計者全新設計；(2)修改設計者過去已經完成之設計；(3)採用他人設計，進行改善；

一若此設計屬於(1)設計者全新設計，不是對已存在之設計進行改版，請於此項目註明“此案件為設計者全新設計”；

一若此設計屬於(2)修改設計者過去已經完成之設計或(3)採用他人設計，進行改善，請於[4]全新設計或改版說明項目註明“此案件為修改設計者過去已經完成之設計”或“此案件為採用他人設計，進行改善”，並說明為何需要進行改版下線，過去下線版本的規格與量測結果，以及說明此次改版的內容有哪些、改善了哪些規格……等資訊(若之前版本量測結果非正常動作，則需分析探討晶片不能正常動作的原因)以利於審查時爭取較好之成績。

”此案件為修改設計者過去已經完成之設計”，相關說明如下：此案件曾經於T18-100C梯次進行下線，經過量測後得到震盪頻率較低(約20GHz)，無法達到規格需求(24.5GHz)，故需要修改設計後再次進行下線以達到規格。

探究T18-100C梯次之晶片量測結果後確認震盪頻率較低的原因為……所造成的，此次設計於……進行改善，修改了……，並於模擬時加入……等相關變數可能造成的影響以降低模擬與量測的差異，除此之外，並將各元件Size與整體布局進行最佳化，使得功率消耗可以更降低，晶片面積也更小。T18-100C晶片與此次設計案規格比較如下表：

Parameter	T18-100C 晶片	This work
Result	Measurement	Post-sim(tt)
Process	0.18um	0.18um
Power Supply (V)	2	2
Total Current (mA)	1.24	1.17
Power Dissipation (mW)	2.48	2.34
Oscillator Frequency (GHz)	20.7	24.15
Phase Noise (dBc/Hz@1MHz)	-108.2	-108.2
Output Power (dBm)	-8	-6.5
Chip size (mm ²)	0.55 x 0.8	0.477 x 0.742

[5] 相關研究發展現況

近年來無線通訊市場的快速成長促進了全世界相關領域的研究和發展…

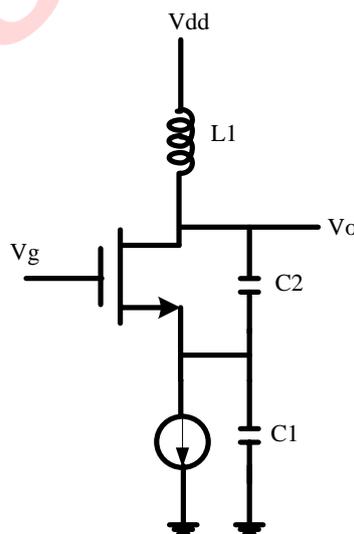
[6] 研究動機

在振盪器決定了提供本地振盪的效能，在傳統 CMOS 振盪器電路設計上…

[7] 架構簡介

請以圖示加文字說明本設計案的架構與電路圖，若有參考文獻的架構與電路圖請放在[4]相關研究發展現況或[5]研究動機中。若設計架構較大，可將設計架構與電路分成數個圖並個別說明，若需於外接電路(或元件)以完成整體架構也請說明之。

如圖一(a)，因為電晶體之汲極電流等於 $(-I_x/SC_1) g_m \dots$

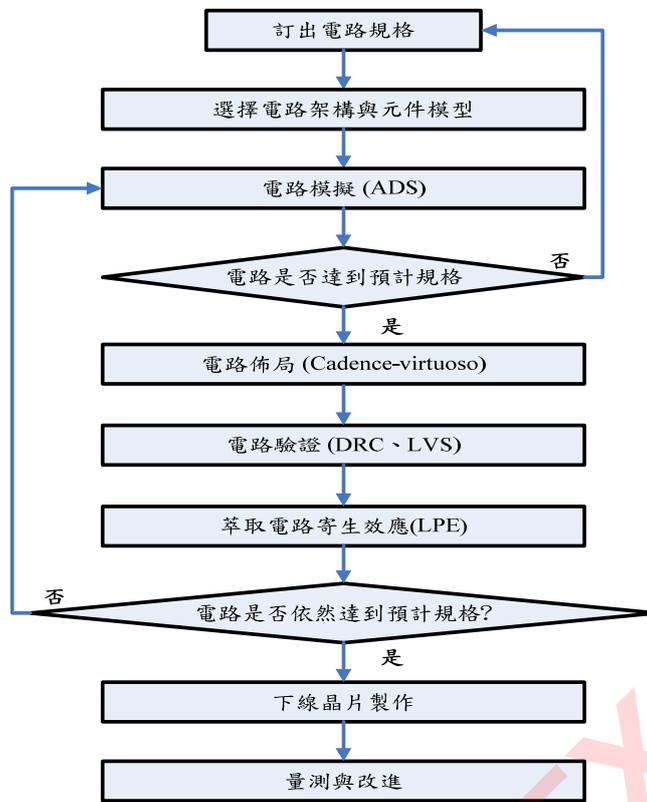


圖一 (a) NMOS Colpitts 振盪器

[8] 設計流程

請以圖示或文字說明設計流程即可。

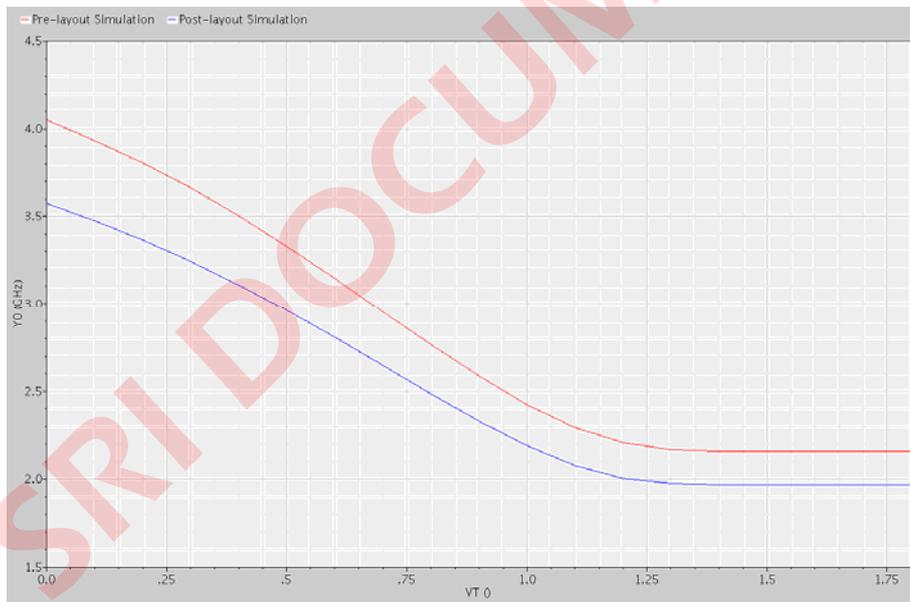
範例：



[9] 模擬結果

請列出 Pre-layout simulation 和 Post-layout simulation 的比較結果。

例一：（曲線重疊）



例二：（以兩張圖表示）

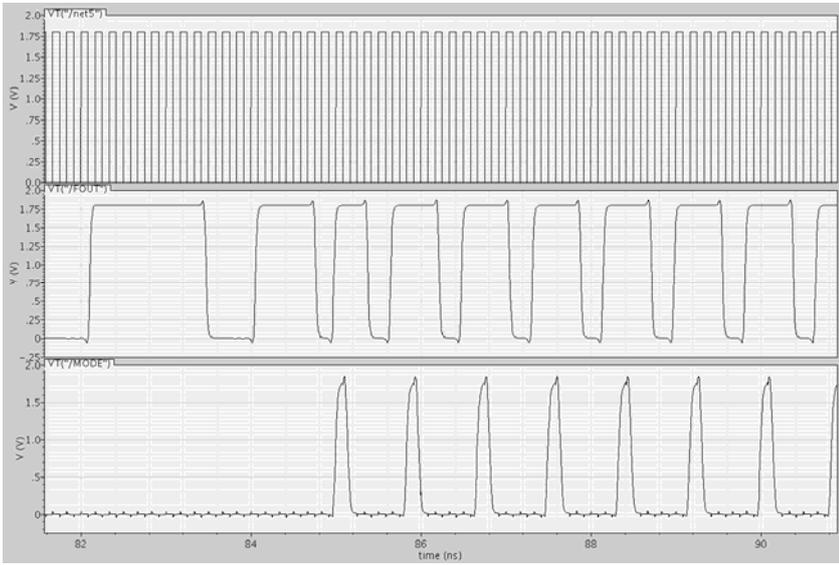


Fig.1 (a) Pre-layout Simulation



Fig.1 (b) Post-layout Simulation

例三：（以表格顯示）

Corner Case simulation

RF Corner	FF	TT	SS
Oscillator Frequency (GHz)	24.15	24.15	24.15
Phase Noise (dBc/Hz@1MHz)	-108.8	-108.2	-108.7
Output Power (dBm)	-6.5(GHz)	-6.5(GHz)	-6.6(GHz)

[10] 量測考量

請以圖示及文字說明儀器架設方式、量測方法等，若有使用 PCB、周邊電路或元件，也且利用圖示或文字說明表示之，不需表明在何處進行量測工作

[11] 佈局驗證結果錯誤說明

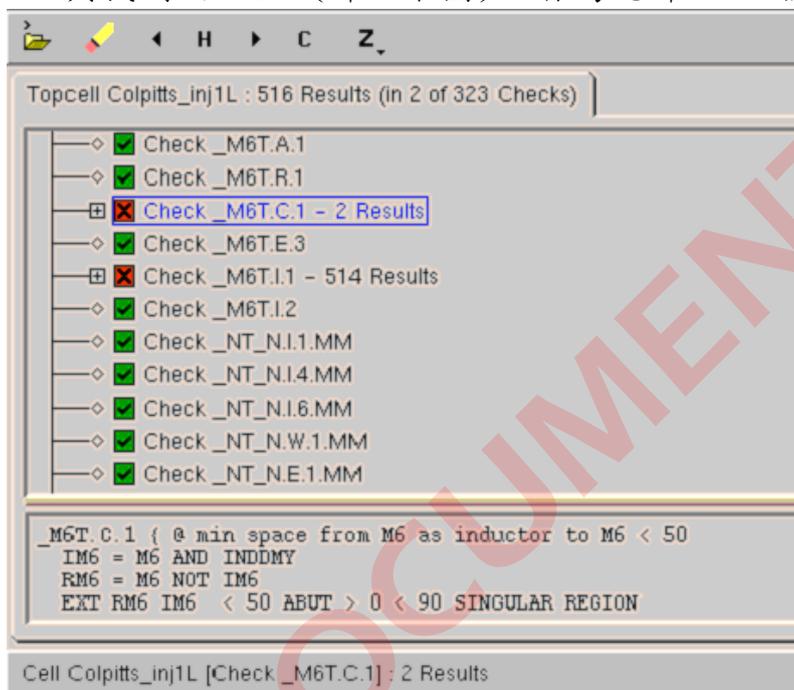
結果只需列出錯誤說明!!如果驗證結果無誤，請以DRC-OK及LVS-OK等字眼表明即可

勿將drc. results、drc. summary、lvs. report內容貼至於此

範例：

(A)DRC驗證結果：

共找到2個錯誤(詳如下圖)且皆為允許之DRC假錯



(B)LVS驗證結果：

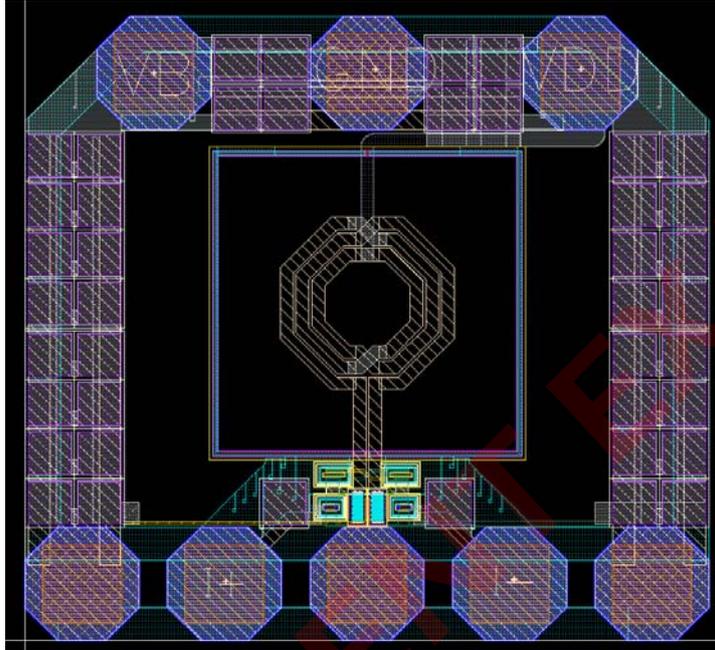
LVS-OK

[12] 佈局平面圖

請確保上傳的gds檔晶片和此佈局照片是相同的!!

否則一律不接受申請晶片申請!!

Chip Size : 0.477 x 0.742 mm²
Transistor/Gate Count : 4Transistors
Power Dissipation : 2.36mW
Max. Frequency : 2.5GHz



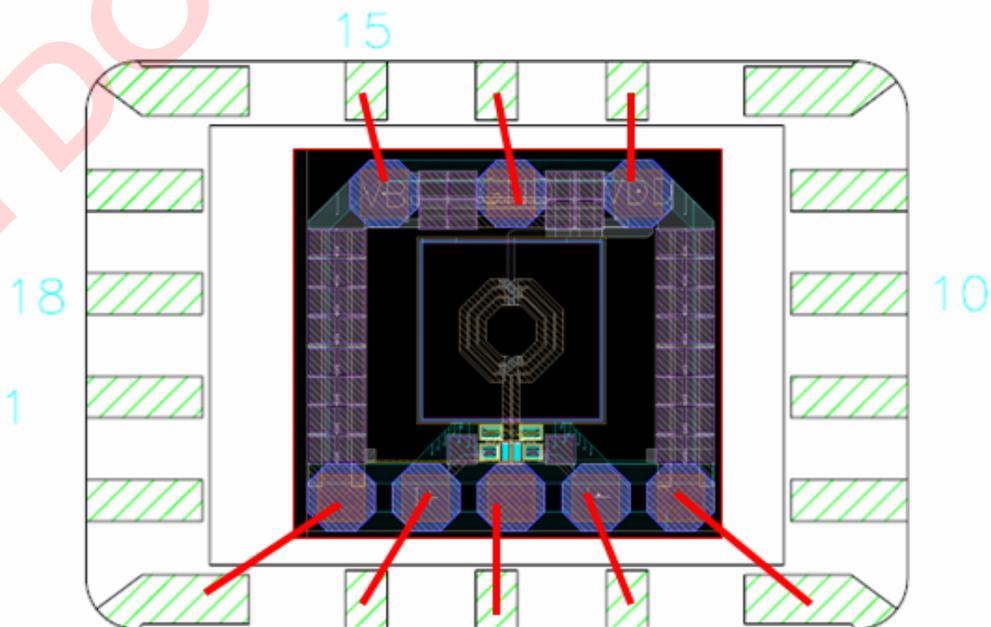
LAYOUT 圖

[13] 打線圖

選擇不包裝之申請者請註明!!(不需打線)

範例：

SB18



打線圖

[14] 預計規格列表

請務必將 **Specification**、**Pre-layout simulation** 和 **Post-layout simulation** 結果以表列方式來呈現!!

範例：

Parameter	Spec.	Pre-sim(tt)	Post-sim(tt)
Power Supply (V)	=2	2	
Total Current (mA)	<1.2	1.18	1.17
Power Dissipation (mW)	<2.4	2.36	2.34
Oscillator Frequency (GHz)	=24.5	24.53	24.15
Phase Noise (dBc/Hz@1MHz)	<-100	-106.3	-108.2
Output Power (dBm)	>-8	-7.6	-6.5
Chip size (mm ²)	<0.5x0.8	0.477 x 0.742	

[15] 效能比較表

請以列表方式來比較此設計與近期研討會、期刊論文所發表相關設計的各项規格與 FOM (Figure-of-Merit) (並請列出 FOM 公式)，以方便委員快速瞭解此設計較其他設計優異之處。若設計內容為完全創新之架構或是系統整合而無法找到可以相互比較之文獻與設計，請說明之。

Parameter	This work	ISSCC20XX[5]	XXX Journal 20XX[6]
Result	Post-sim(tt)	Measurement	Measurement
Process	0.18um	0.18um	0.18um
Power Supply (V)	2	2	1.8
Total Current (mA)	1.17	1.3	1.5
Power Dissipation (mW)	2.34	2.6	2.7
Oscillator Frequency (GHz)	24.15	25	24
Phase Noise (dBc/Hz@1MHz)	-108.2	-99	-101
Output Power (dBm)	-6.5	-7.2	-7.0
Chip size (mm ²)	0.477 x 0.742	0.5 x 0.5	0.6 x 0.5
FOM	xxx	ooo	***

*FOM 公式：FOM=.....

*比較之論文列於參考文獻項目中

[16] 參考文獻

[1] Ming-Da Tsai, "A 5-GHz Low Phase Noise Differential Colpitts CMOS VCO", IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS, VOL. 15, NO. 5, MAY 2005.